

## 【1000～2000万円】Power Device Design Senior Engineer

外資系デバイスメーカーでの募集です。電子デバイス研究開発のご経験のある方は歓...

### Job Information

#### Recruiter

JAC Recruitment Co., Ltd.

#### Hiring Company

外資系デバイスメーカー

#### Job ID

1550066

#### Industry

Communication

#### Company Type

International Company

#### Job Type

Permanent Full-time

#### Location

Osaka Prefecture

#### Salary

10 million yen ~ 20 million yen

#### Work Hours

09:00 ~ 18:00

#### Holidays

【有給休暇】有給休暇は入社後4ヶ月目から付与されます 初年度 14日 4か月目から 【休日】完全週休二日制 土日 夏季休暇 ...

#### Refreshed

February 6th, 2026 16:00

### General Requirements

#### Career Level

Mid Career

#### Minimum English Level

Business Level

#### Minimum Japanese Level

Native

#### Minimum Education Level

Bachelor's Degree

#### Visa Status

Permission to work in Japan required

### Job Description

#### 【求人No NJB2224778】

- ・高性能パワーデバイス（SiC MOSFET/SBD、GaN HEMT、Si IGBT）のデザイン開発とテスト検証を担当し、プロセスチームと協力してデバイス加工とプロセスの最適化を行う。
- ・高性能パワーデバイス（SiC MOSFET/SBD、GaN HEMT、Si IGBT）の個別技術をフォローアップし、既存のデバイスの性能を向上させ、パテントポートフォリオを提案して実現させる。

### Required Skills

必須要件

- ・半導体/電子/物理などの関連分野を専攻し、5年以上のパワーデバイスのデザイン開発経験（直近の3年間には関連のデザイン開発の従事が必須）、または優秀な博士課程の新卒者。
- ・パワーデバイス（SiC MOSFET/SBD、GaN HEMT、Si IGBT）の基本構造とデバイスシミュレーションデザイン方法に精通し、TCADソフトやレイアウトソフトを使用しデバイスデザインが得意な方。
- ・良好なコミュニケーション能力があり、異なる地域や異なる文化背景のチームと良好なコミュニケーションがとれる方。

---

### Company Description

ご紹介時にご案内いたします